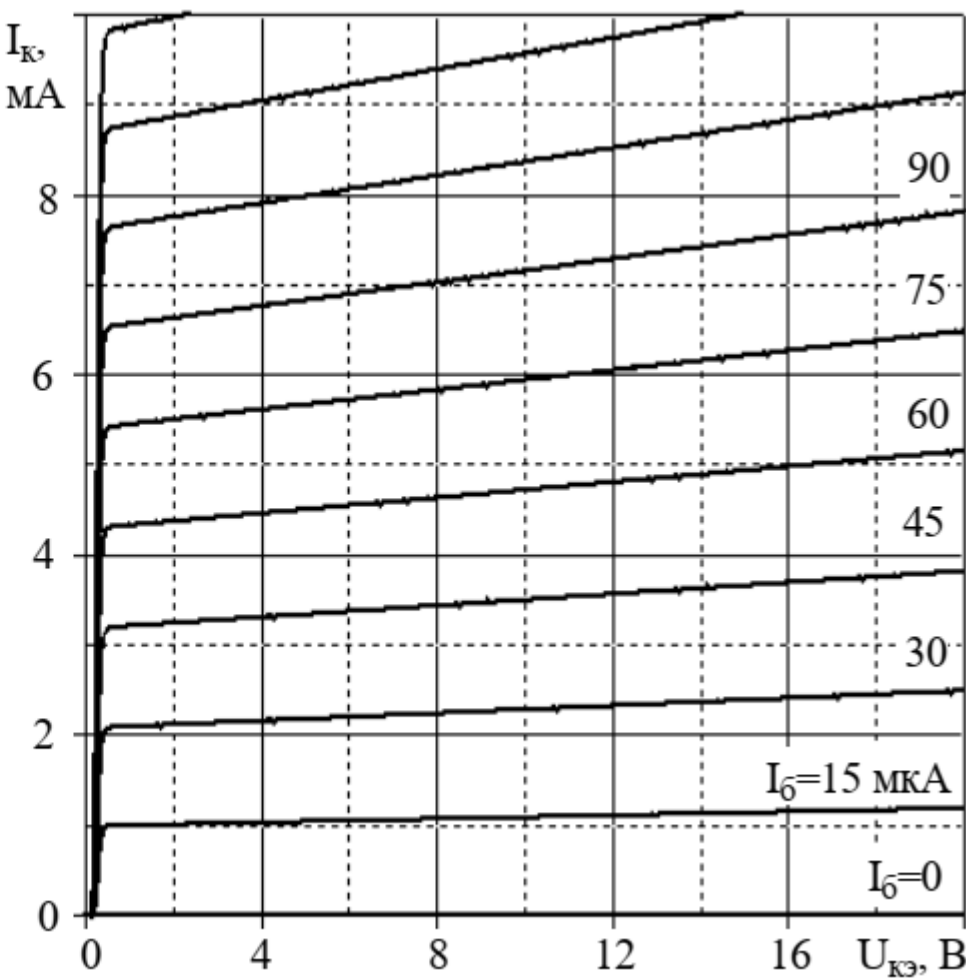
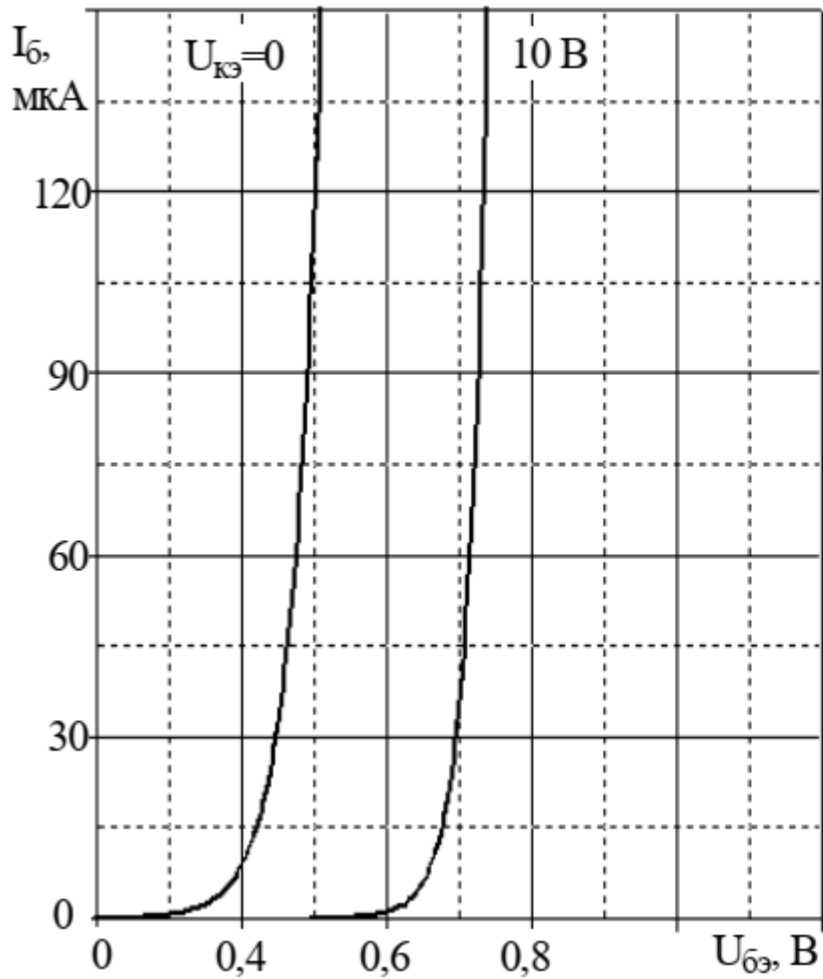


Биполярный транзистор КТ315Г

Структура	n-p-n
$h_{21Э}$ min...max	50...350 ($U_{КЭ} = 10В, I_K = 1mA$)
$f_{гр}$, МГц	250
C_K , пФ	7
$C_Э$, пФ	20
$I_{КБ0}$, мкА	1 ($T=25^{\circ}$)

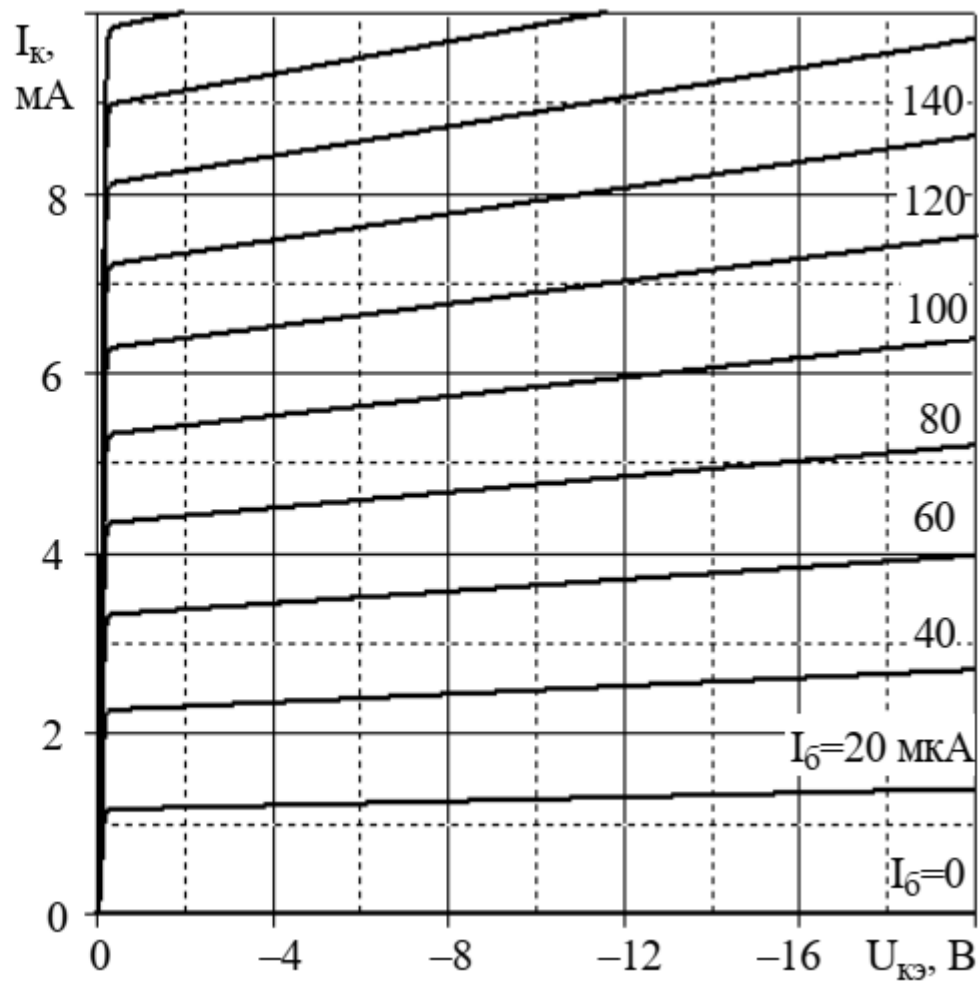
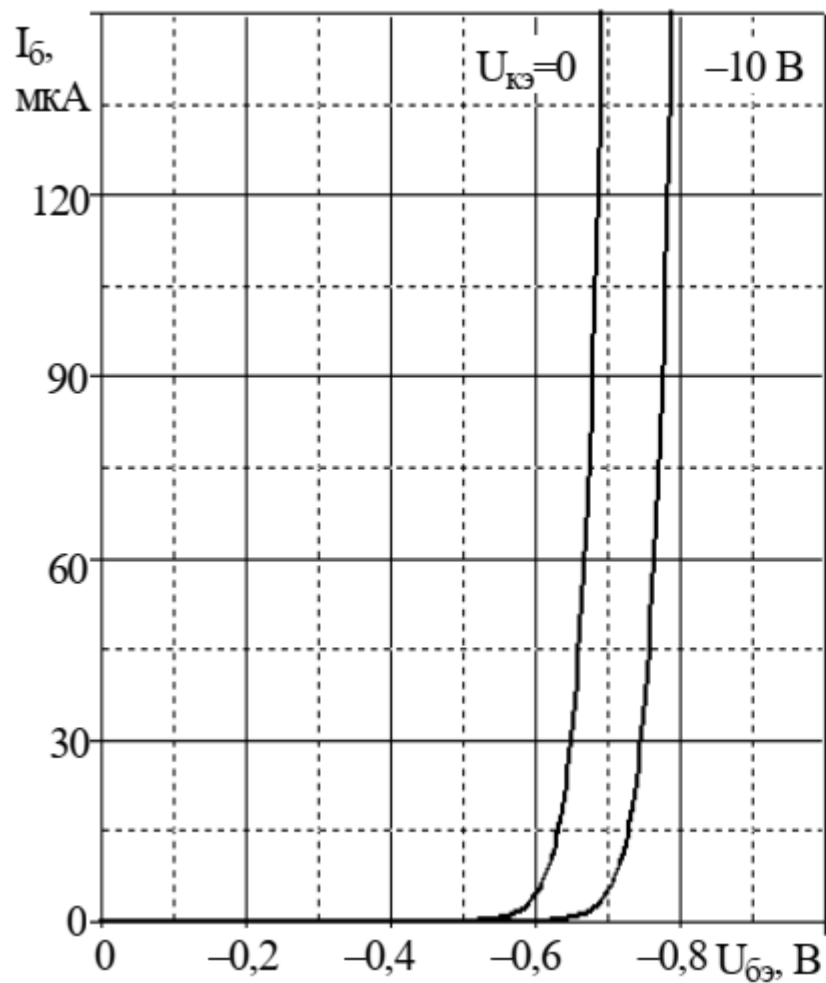
$U_{КЭ\text{ нас}}$, В	0.4
$U_{КЭ\text{ max}}$, В	35
$I_{K\text{ max}}$, мА	100
$P_{K\text{ max}}$, Вт	0.150



Биполярный транзистор КТ337Б

Структура	p-n-p
$h_{21Э} \min...max$	50...75 ($U_{КЭ} = -10V, I_K = 0,3mA$)
$f_{гр}, МГц$	500
$C_K, пФ$	5
$C_Э, пФ$	5
$I_{КБ0}, мкА$	1 ($T=25^\circ$)

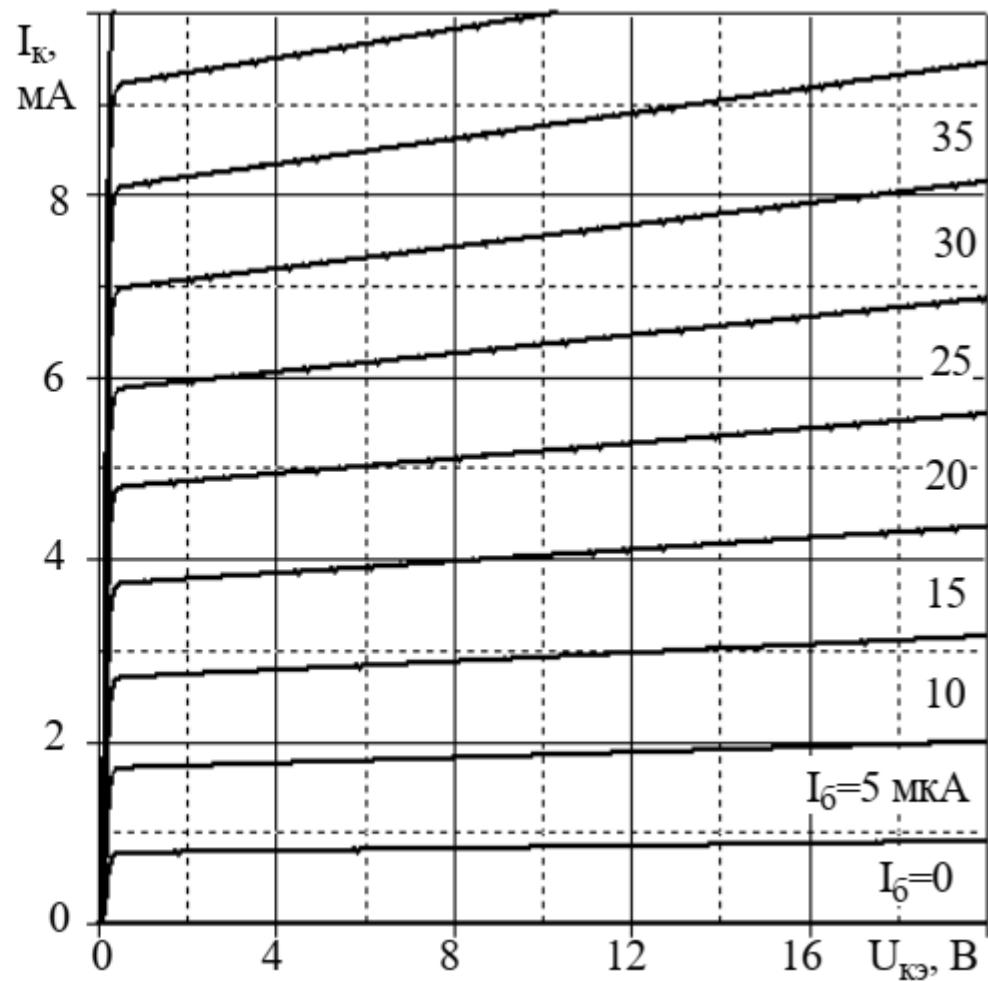
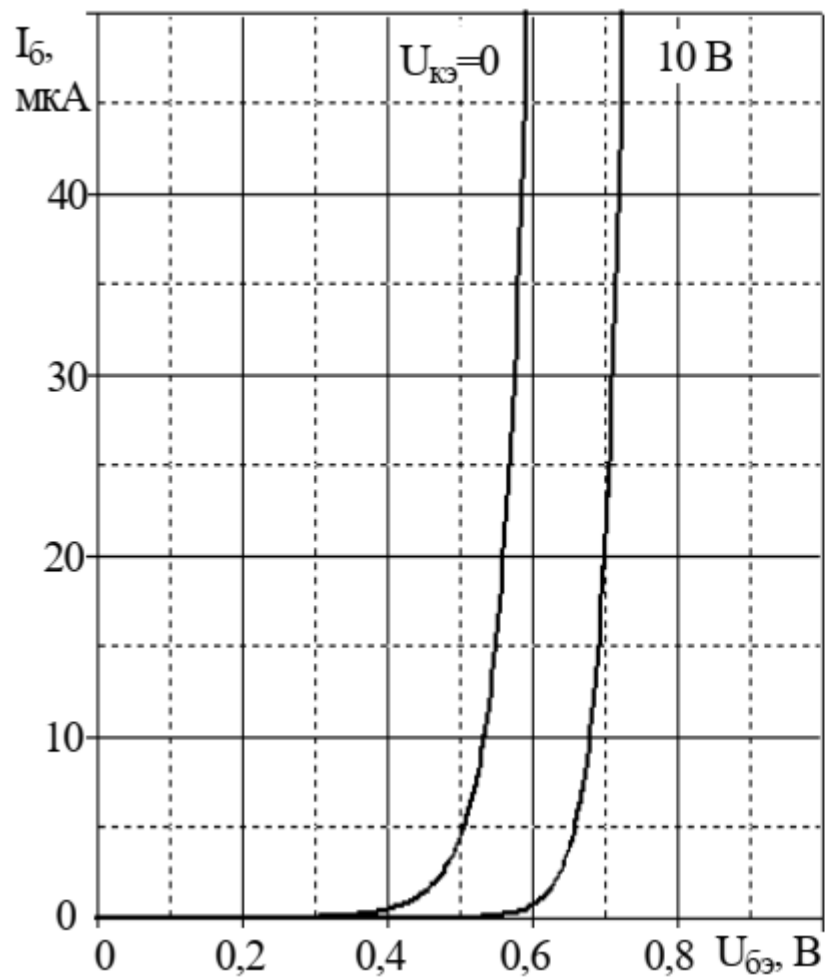
$U_{КЭ \text{ нас}}, В$	-0.2
$U_{КЭ \text{ max}}, В$	-20
$I_{K \text{ max}}, мА$	30
$P_{K \text{ max}}, Вт$	0.150



Биполярный транзистор КТ342А

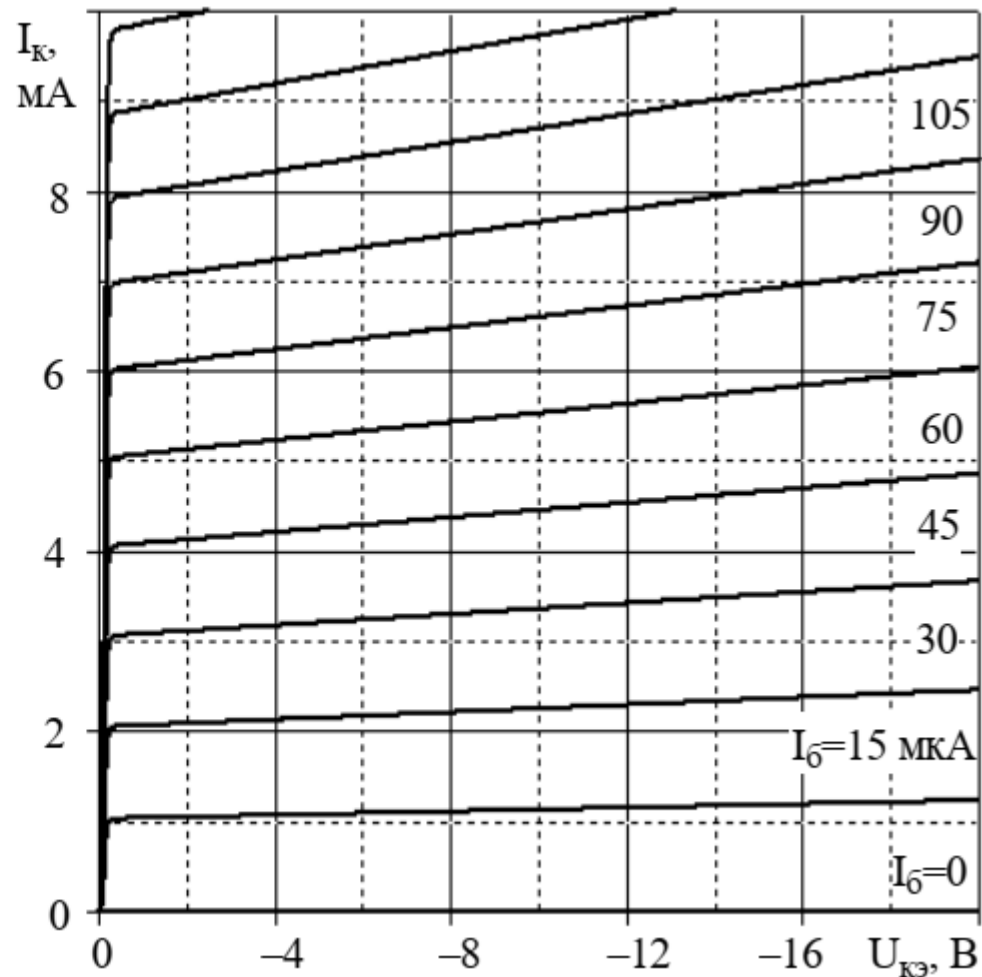
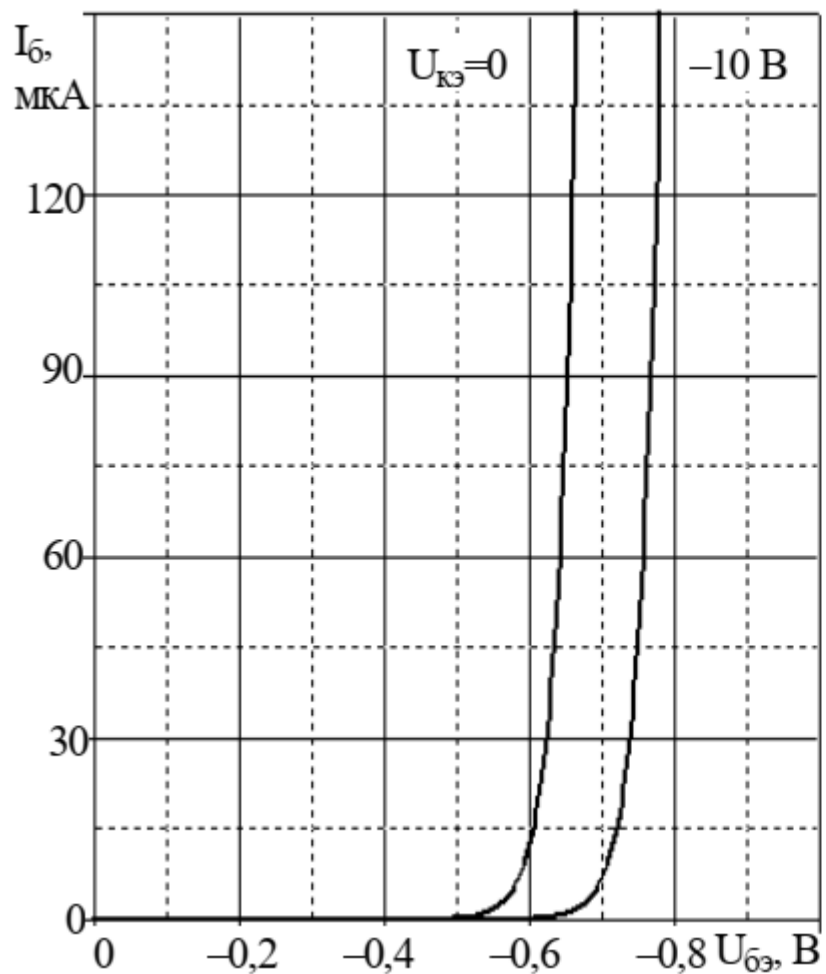
Структура	n-p-n
$h_{21Э}$ min...max	100...250 ($U_{КЭ} = 5В$, $I_K = 1mA$)
$f_{гр}$, МГц	300
C_K , пФ	8
$C_Э$, пФ	16
$I_{КБ0}$, мкА	0,05 ($T=25^{\circ}$)

$U_{КЭ\text{ нас}}$, В	0.1
$U_{КЭ\text{ max}}$, В	30
$I_{K\text{ max}}$, мА	50
$P_{K\text{ max}}$, Вт	0.250



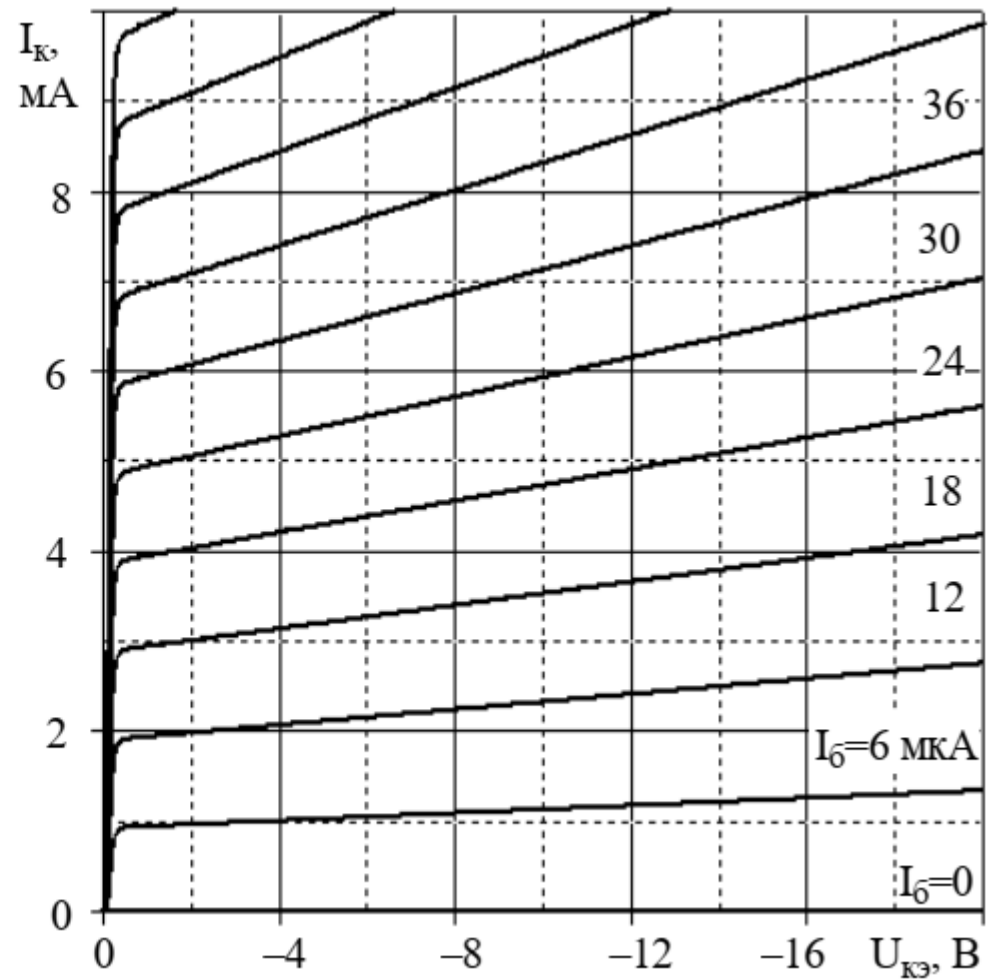
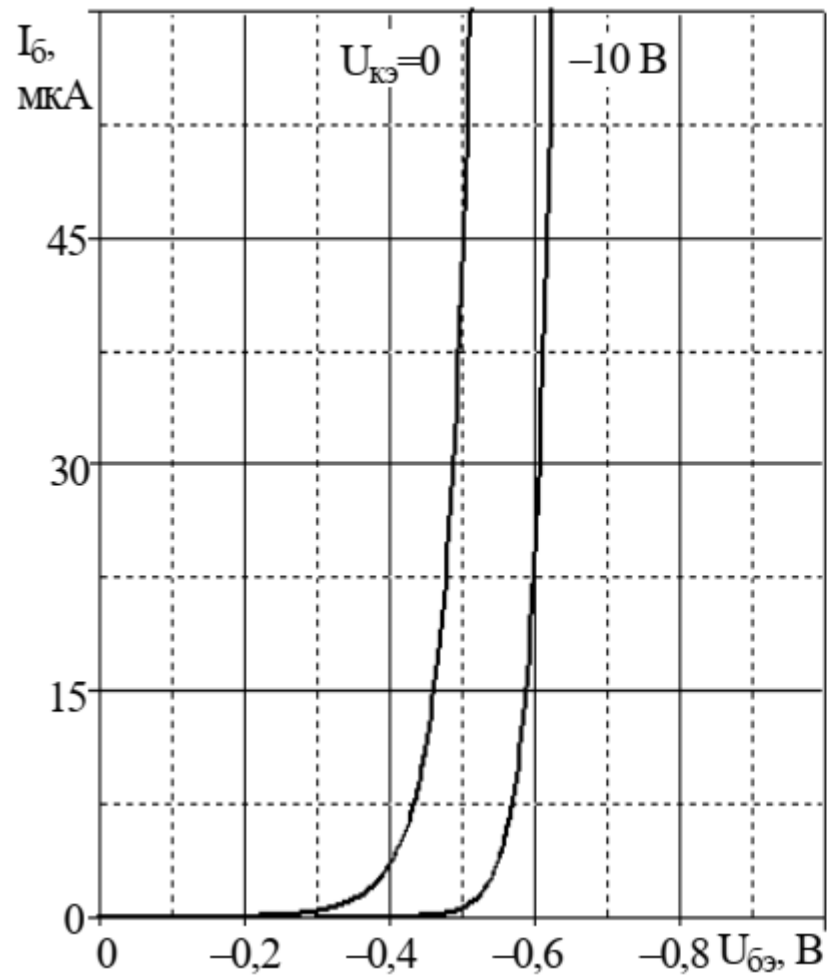
Биполярный транзистор КТ347А

Структура	р-п-р	$U_{КЭ\text{ нас, В}}$	-0.3
$h_{21Э}\text{ min...max}$	30...400 ($U_{КЭ} = -10\text{В}, I_K = 0,3\text{мА}$)	$U_{КЭ\text{ max, В}}$	-20
$f_{гр, МГц}$	500	$I_{К\text{ max, мА}}$	50
$C_k, пФ$	6	$P_{К\text{ max, Вт}}$	0.150
$Cэ, пФ$	8		
$I_{КБ0, мкА}$	1 ($T=25^\circ$)		



Биполярный транзистор КТ349Б

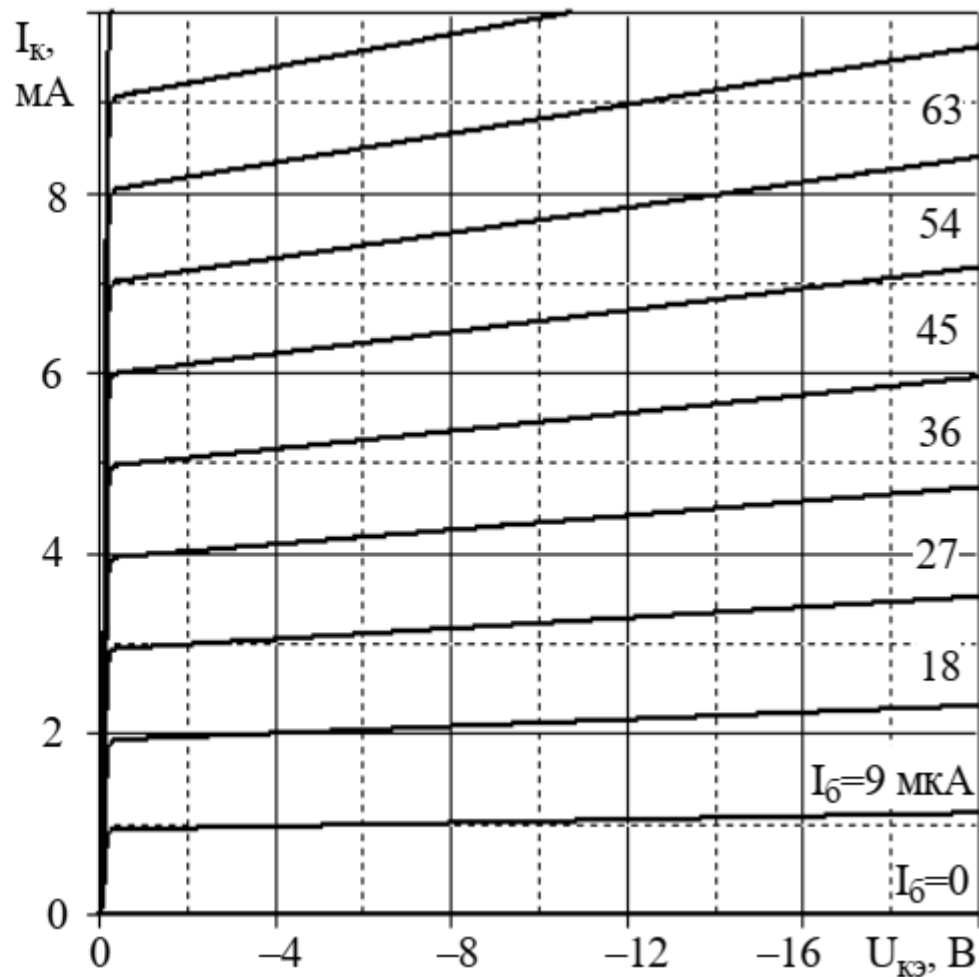
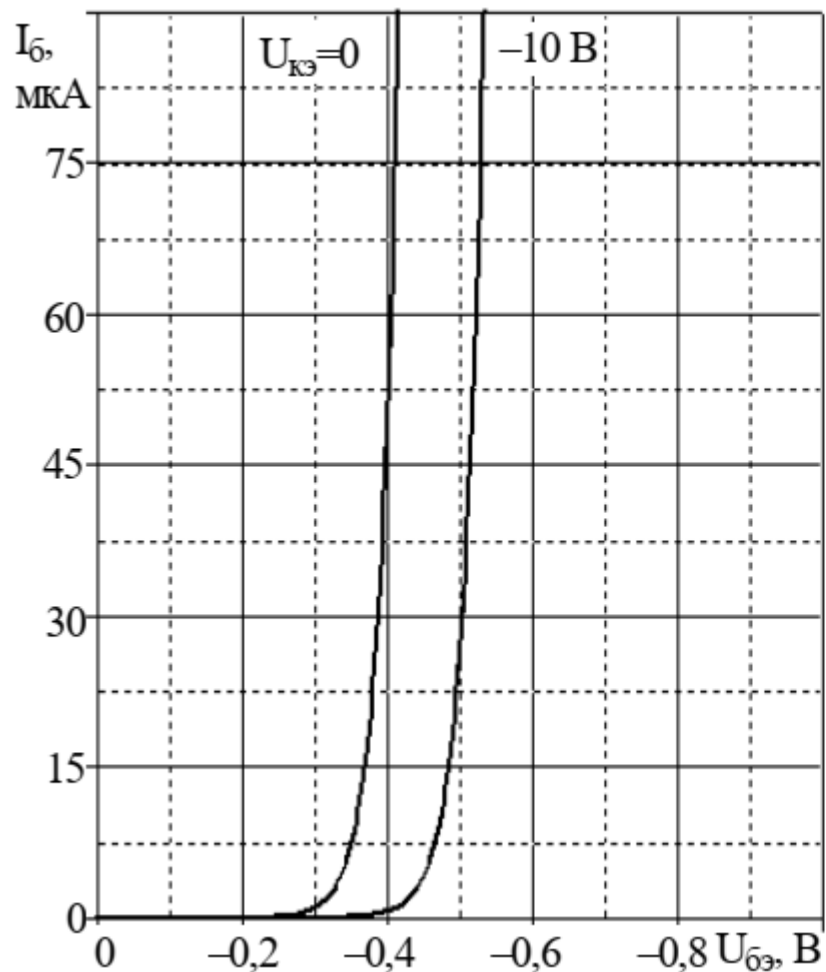
Структура	p-n-p	$U_{КЭ\text{ нас, В}}$	-0.3
$h_{21Э}\text{ min...max}$	30...400 ($U_{КЭ} = -10\text{В}, I_K = 0,2\text{мА}$)	$U_{КЭ\text{ max, В}}$	-20
$f_{гр, МГц}$	500	$I_{К\text{ max, мА}}$	20
$C_K, пФ$	6	$P_{К\text{ max, Вт}}$	0.200
$C_э, пФ$	8		
$I_{КБ0, мкА}$	1 ($T=25^\circ$)		



Биполярный транзистор КТ350А

Структура	р-п-р
$h_{21Э}$ min...max	20...200 ($U_{КЭ} = -10В$, $I_K = 0,5mA$)
$f_{гр}$, МГц	100
C_K , пФ	70
$C_Э$, пФ	100
$I_{КБ0}$, мкА	1 ($T=25^\circ$)

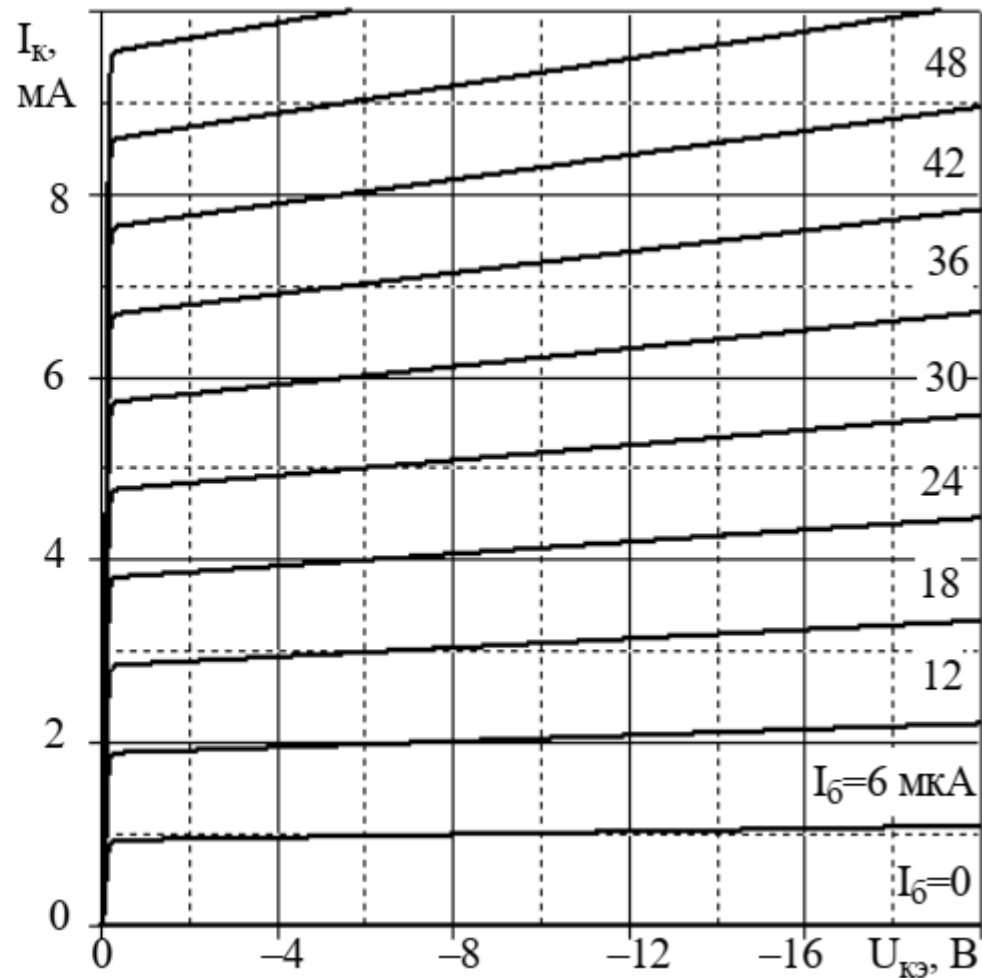
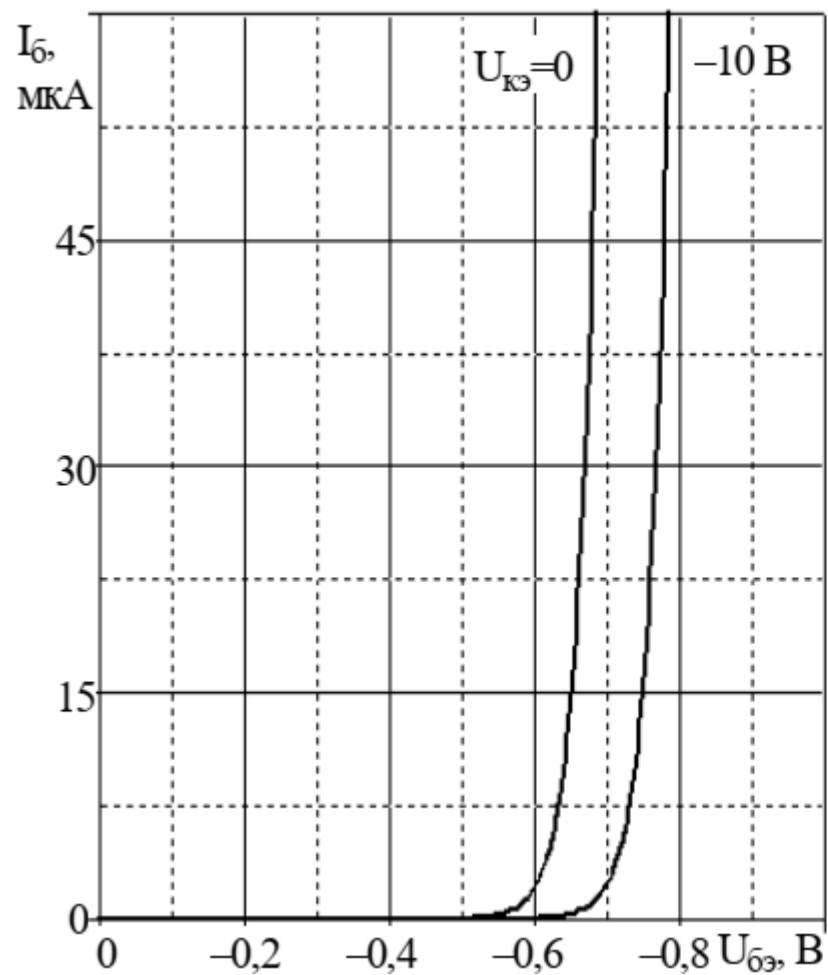
$U_{КЭ\text{ нас}}$, В	-0.3
$U_{КЭ\text{ max}}$, В	-20
$I_{K\text{ max}}$, мА	60
$P_{K\text{ max}}$, Вт	0.300



Биполярный транзистор КТ351А

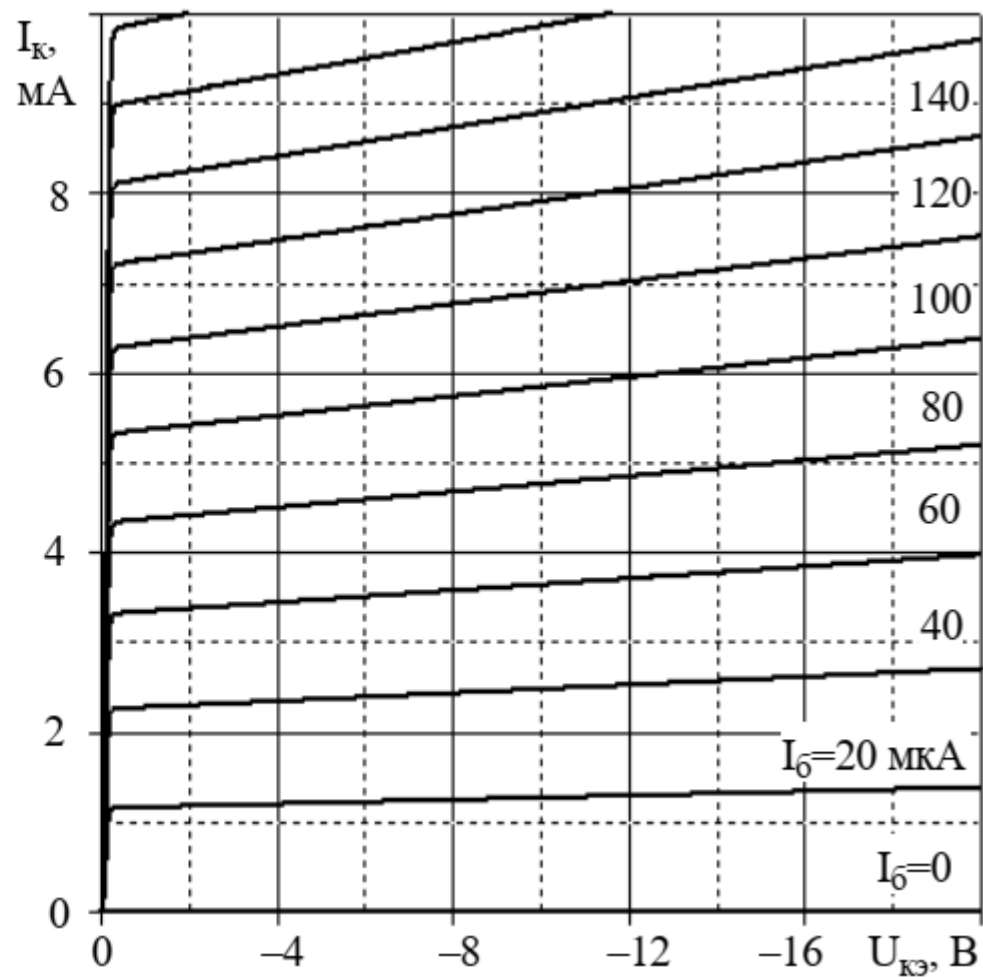
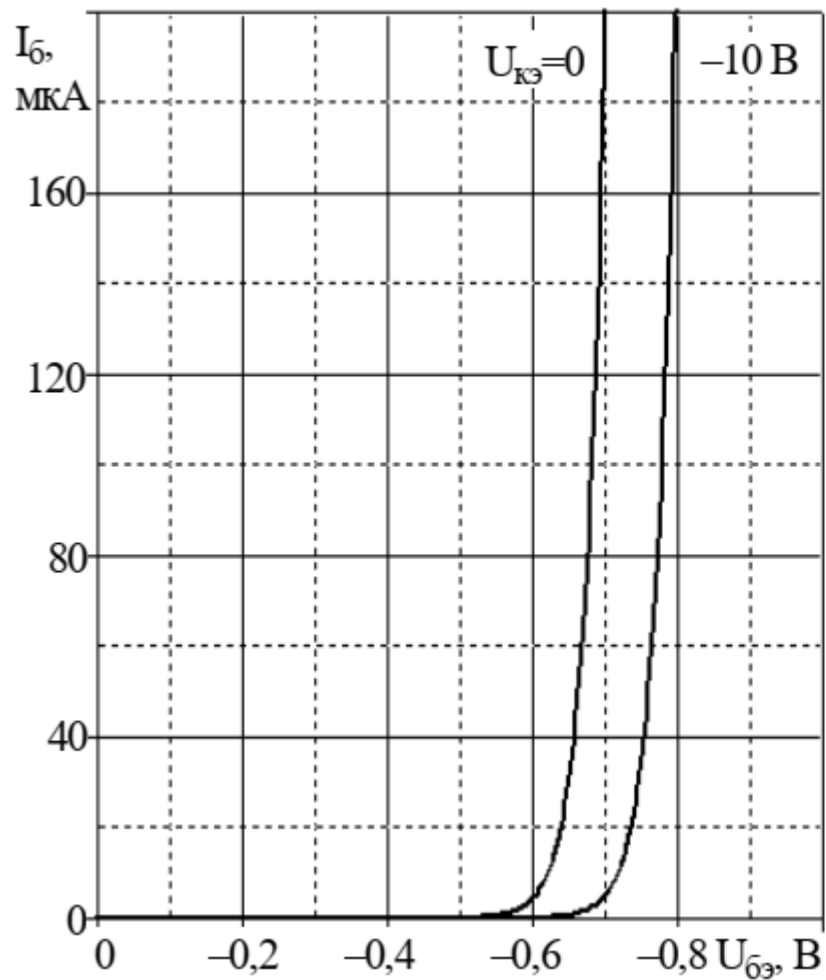
Структура	р-п-р
$h_{21Э} \min...max$	20...80 ($U_{КЭ} = -10В, I_K = 0,5mA$)
$f_{гр}, МГц$	200
$C_k, пФ$	20
$C_э, пФ$	30
$I_{КБ0}, мкА$	0,5 ($T=25^{\circ}$)

$U_{КЭ \text{ нас}}, В$	-0.3
$U_{КЭ \text{ max}}, В$	-20
$I_{K \text{ max}}, mA$	30
$P_{K \text{ max}}, Вт$	0.225



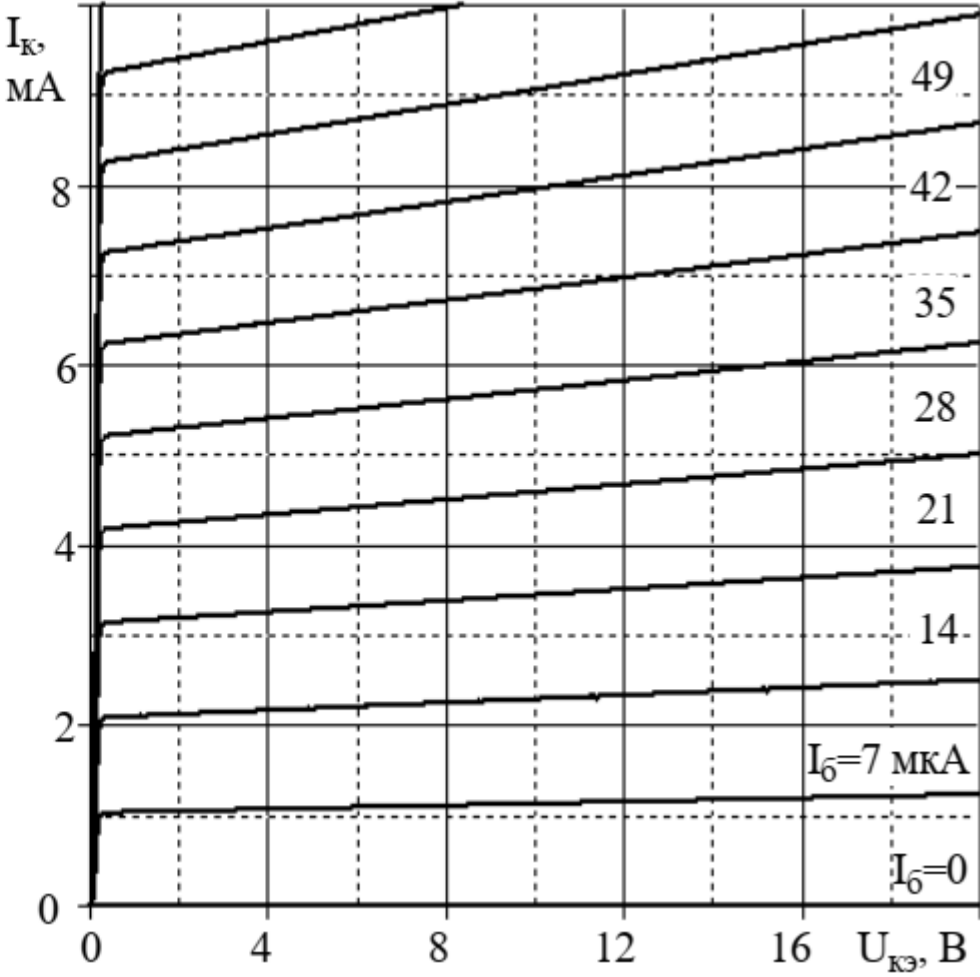
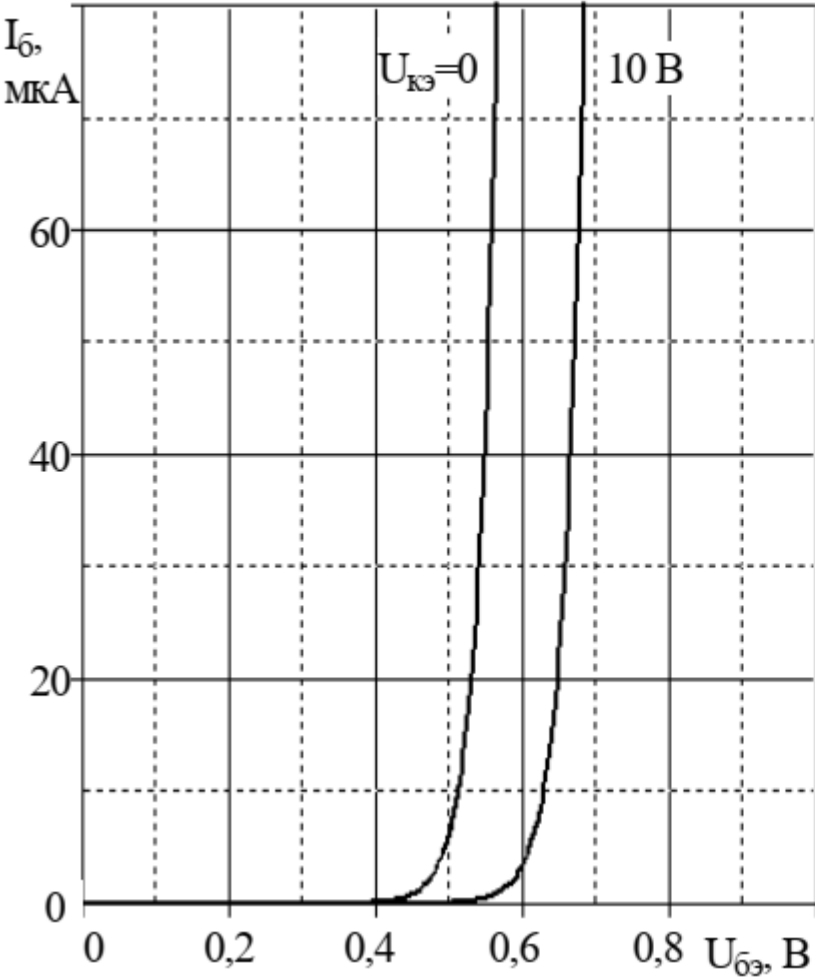
Биполярный транзистор КТ357А

Структура	р-п-р	$U_{КЭ\text{ нас, В}}$	-0.4
$h_{21Э\text{ min...max}}$	20...100 ($U_{КЭ} = -10\text{В}, I_K = 1\text{мА}$)	$U_{КЭ\text{ max, В}}$	-20
$f_{гр, МГц}$	300	$I_{К\text{ max, мА}}$	40
$C_k, пФ$	7	$P_{К\text{ max, Вт}}$	0.100
$C_э, пФ$	10		
$I_{КБ0, мкА}$	5 ($T=25^\circ$)		



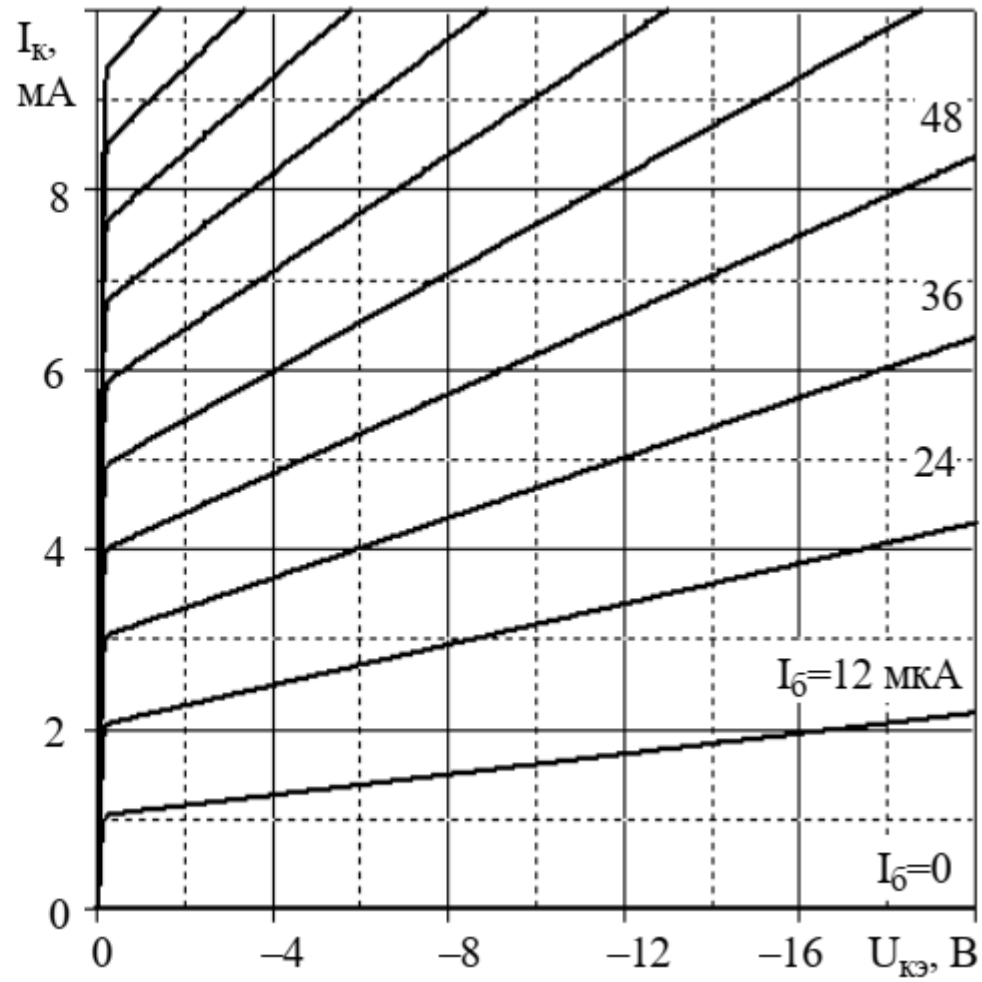
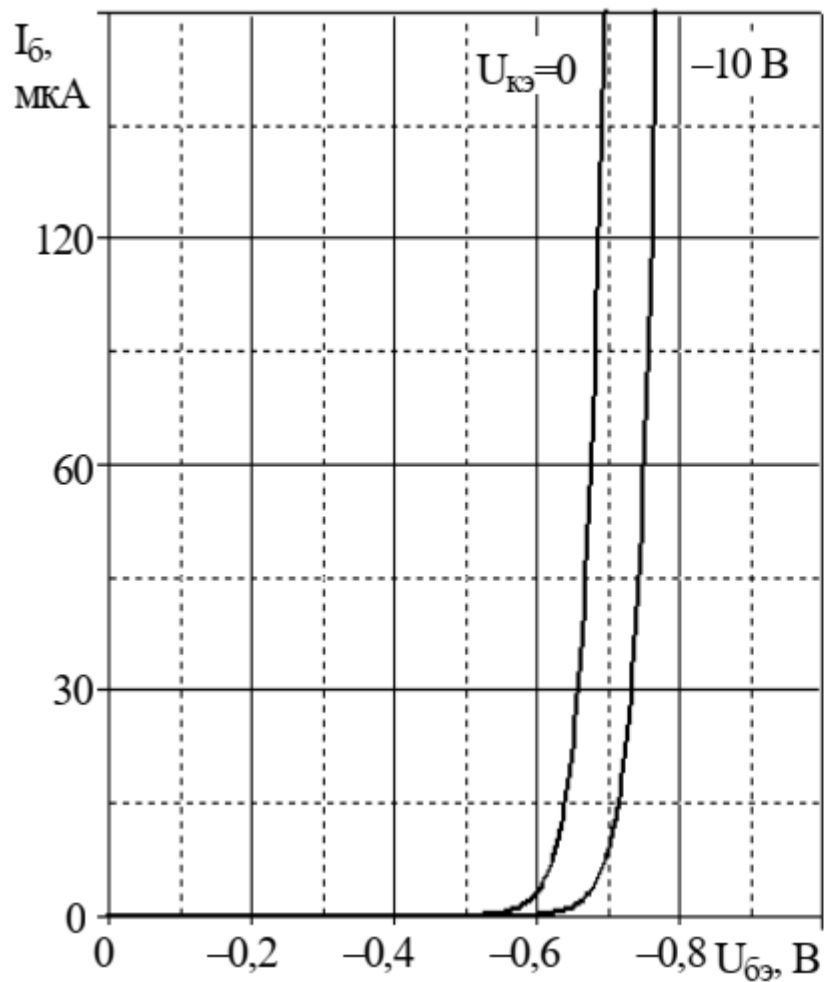
Биполярный транзистор КТ358Б

Структура	n-p-n	$U_{КЭ\text{ нас, В}}$	0.8
$h_{21Э\text{ min...max}}$	10...100 ($U_{КЭ} = 5,5\text{В}, I_K = 10\text{мА}$)	$U_{КЭ\text{ max, В}}$	30
$f_{гр, МГц}$	120	$I_{К\text{ max, мА}}$	30
$C_k, пФ$	7	$P_{К\text{ max, Вт}}$	0.100
$Cэ, пФ$	10		
$I_{КБ0, мкА}$	10 ($T=25^{\circ}$)		



Биполярный транзистор КТ361Г

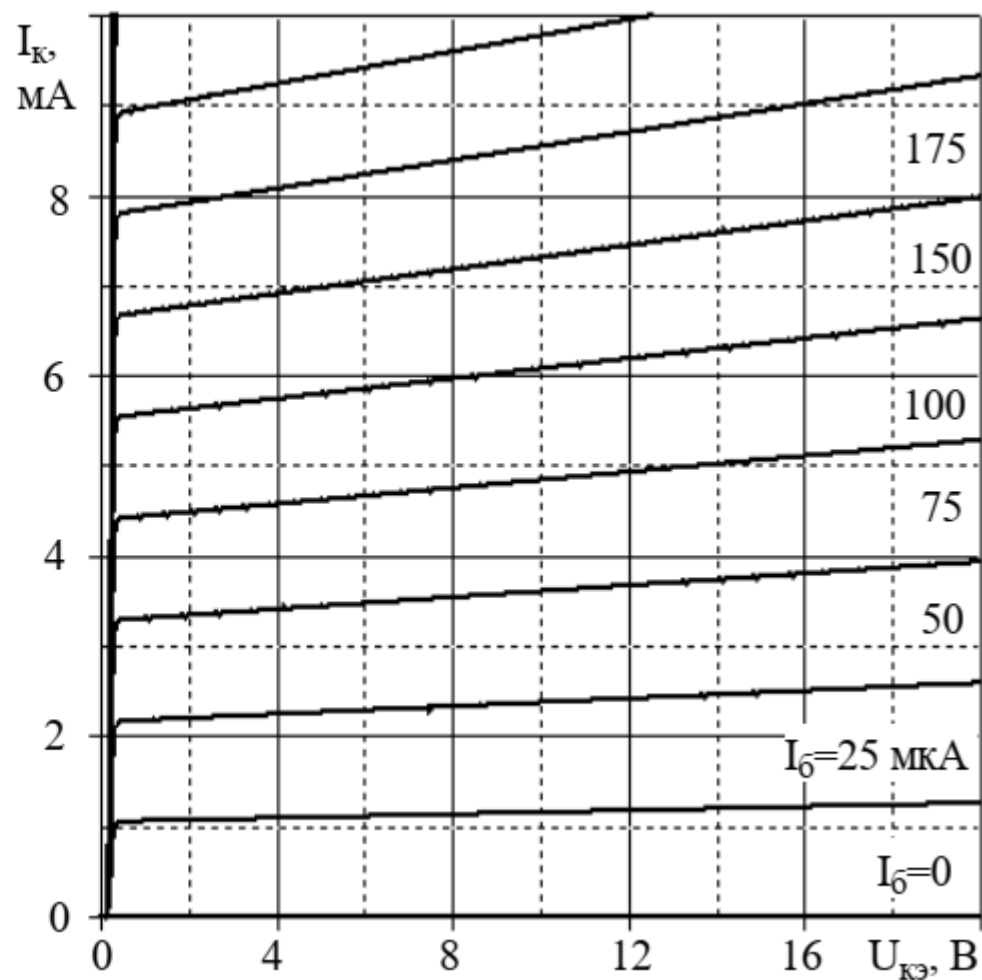
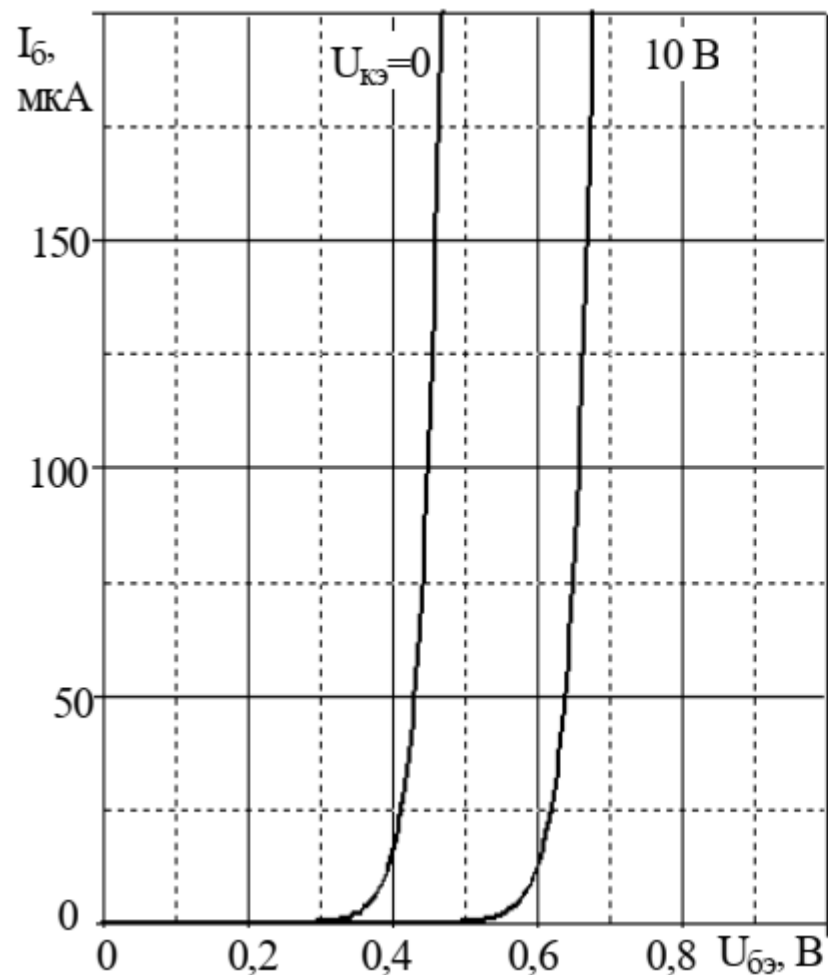
Структура	p-n-p	$U_{КЭ\text{ нас, В}}$	-0.2
$h_{21Э}\text{ min...max}$	50...350 ($U_{КЭ} = -10\text{В}, I_K = 1\text{мА}$)	$U_{КЭ\text{ max, В}}$	-35
$f_{гр, МГц}$	250	$I_{К\text{ max, мА}}$	50
$C_k, пФ$	7	$P_{К\text{ max, Вт}}$	0.150
$Cэ, пФ$	20		
$I_{КБ0, мкА}$	1 ($T=25^\circ$)		



Биполярный транзистор КТ375Б

Структура	n-p-n
$h_{21Э} \text{ min...max}$	50...280 ($U_{КЭ} = 10\text{В}$, $I_K = 1\text{мА}$)
$f_{гр}$, МГц	600
C_K , пФ	5
$C_Э$, пФ	20
$I_{КБ0}$, мкА	1 ($T=25^\circ$)

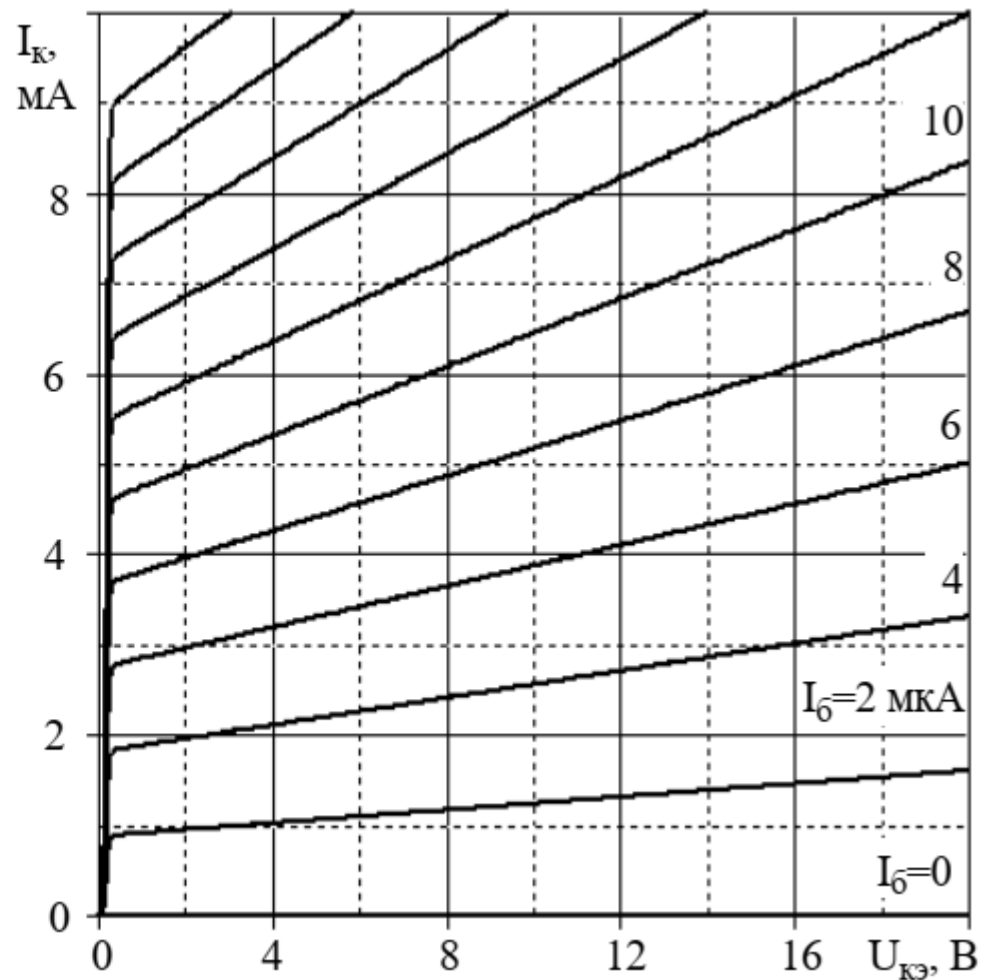
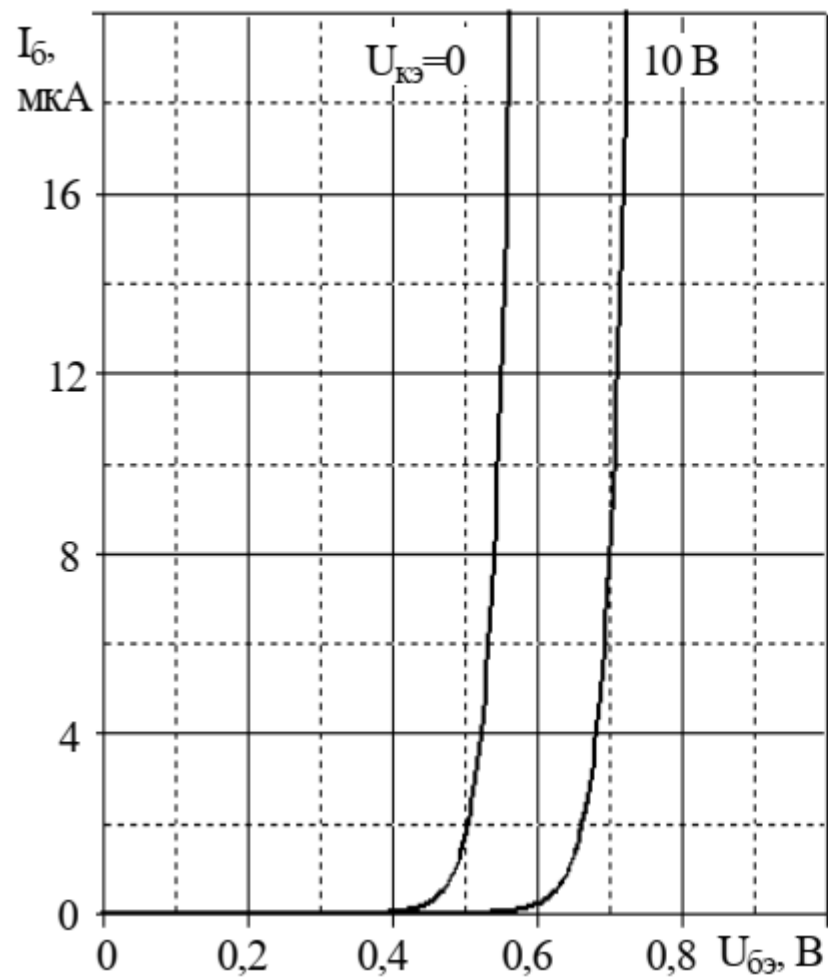
$U_{КЭ \text{ нас}}$, В	0.2
$U_{КЭ \text{ max}}$, В	30
$I_{K \text{ max}}$, мА	100
$P_{K \text{ max}}$, Вт	0.200



Биполярный транзистор КТ3102Г

Структура	n-p-n
$h_{21Э}$ min...max	200...500 ($U_{КЭ} = 5В$, $I_K = 2мА$)
$f_{гр}$, МГц	300
C_K , пФ	6
$C_Э$, пФ	15
$I_{КБ0}$, мкА	0,05 ($T=25^\circ$)

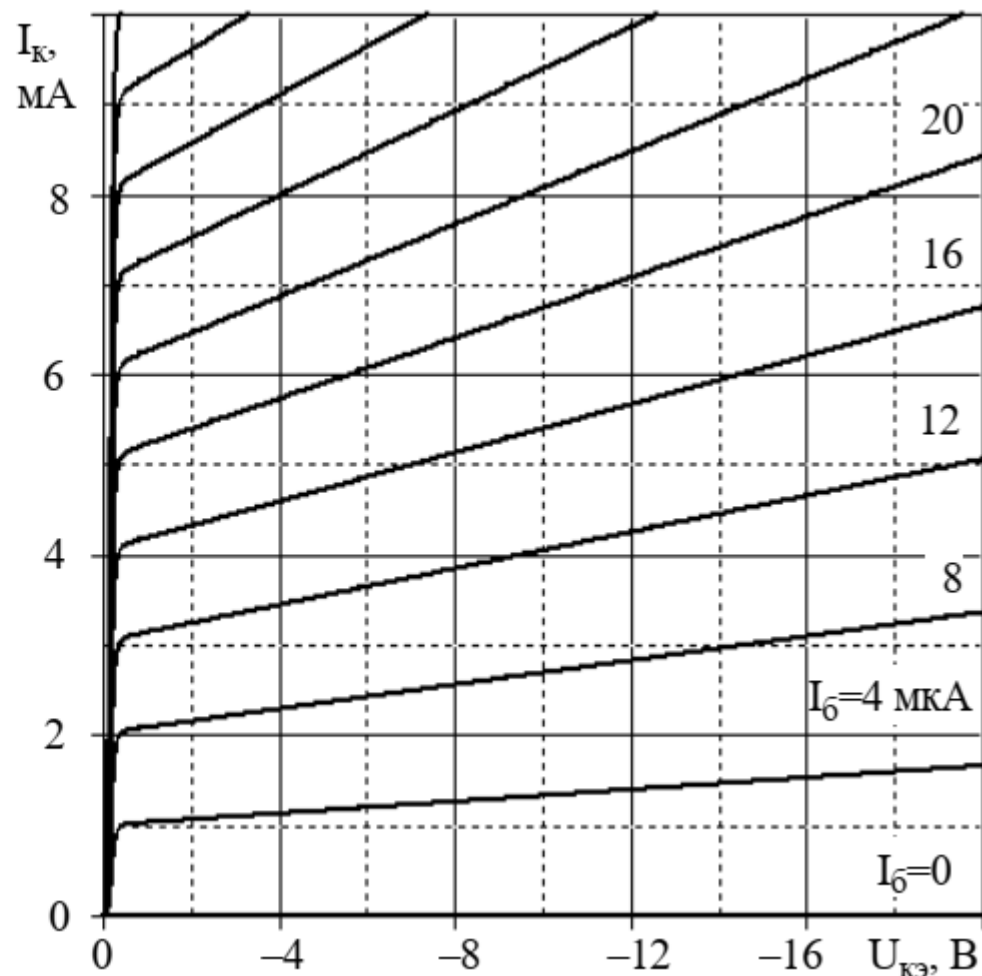
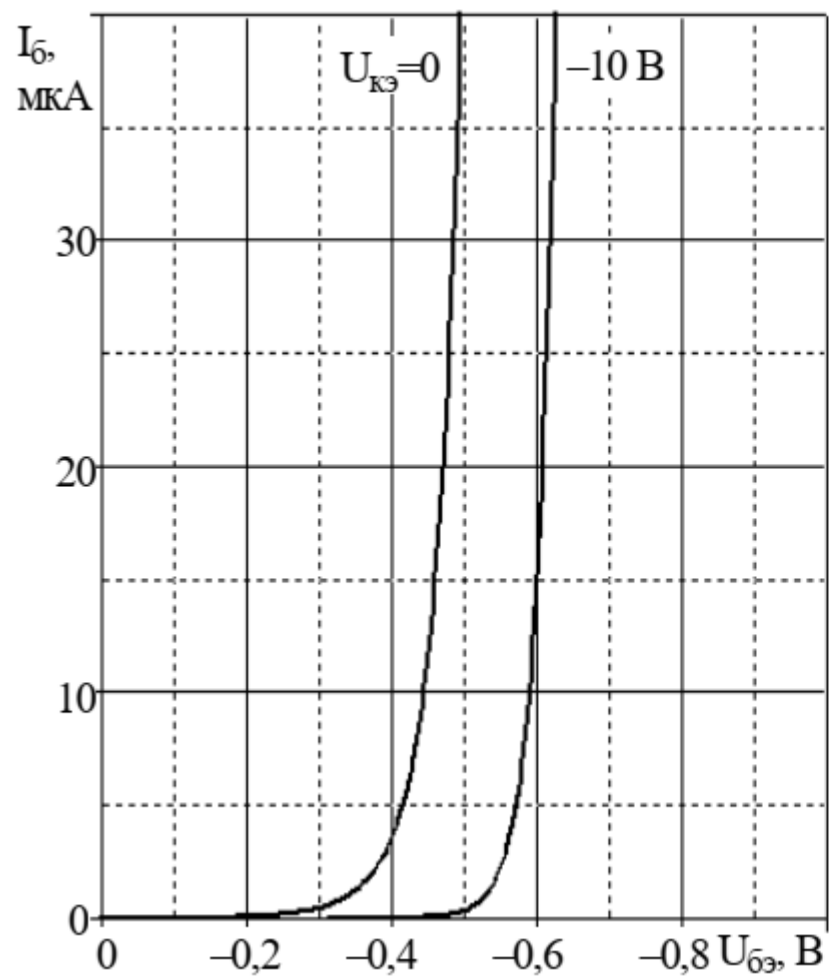
$U_{КЭ\text{ нас}}$, В	0.2
$U_{КЭ\text{ max}}$, В	20
$I_{K\text{ max}}$, мА	100
$P_{K\text{ max}}$, Вт	0.250



Биполярный транзистор КТ3107Г

Структура	р-п-р
$h_{21Э} \min...max$	120...200 ($U_{КЭ} = -10В, I_K = 1mA$)
$f_{гр}, МГц$	200
$C_k, пФ$	7
$C_э, пФ$	20
$I_{КБ0}, мкА$	0,1 ($T=25^{\circ}$)

$U_{КЭ \text{ нас}}, В$	-0.2
$U_{КЭ \text{ max}}, В$	-25
$I_{K \text{ max}}, mA$	100
$P_{K \text{ max}}, Вт$	0.300



Биполярный транзистор КТ3117А

Структура	n-p-n
$h_{21Э} \min...max$	40...200 ($U_{КЭ} = 5В, I_K = 20mA$)
$f_{гр}, МГц$	250
$C_K, пФ$	10
$C_Э, пФ$	80
$I_{КБ0}, мкА$	10 ($T=25^\circ$)

$U_{КЭ \text{ нас}}, В$	0.6
$U_{КЭ \text{ max}}, В$	60
$I_{K \text{ max}}, mA$	400
$P_{K \text{ max}}, Вт$	0.300

